


	<h2 style="color: red;">FQA6N90_F109</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQA6N90_F109
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 6.4A TO-3P
	Datenblätter:  FQA6N90_F109.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


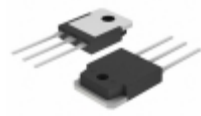



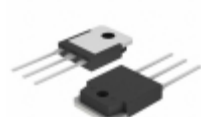


Spezifikationen

Teilenummer	FQA6N90_F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 6.4A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	198W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Andere Namen	FQA6N90-F109
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1880pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 6.4A (Tc) 198W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.4A (Tc)

FQA6N90_F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQA6N90_F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQA6N90_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQA6N90_F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQA6N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.4A TO-3P</p>	 <p>FQA6N90C-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-3P</p>	 <p>FQA70N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 70A TO-3P</p>	 <p>FQA6N90C FSC FQA6N90C FSC</p>
 <p>FQA6N90_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.4A TO-3P</p>	 <p>FQA70N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 70A TO-3P</p>	 <p>FQA70N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 70A TO-3P</p>	 <p>FQA6N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.4A TO-3P</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQA6N90_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQA6N90_F109 Datenblatt	FQA6N90_F109-Datenblätter	FQA6N90_F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQA6N90_F109
FQA6N90_F109 Electronic	FQA6N90_F109-Komponenten	FQA6N90_F109-Verteiler	FQA6N90_F109-Bild	FQA6N90_F109-Teil
FQA6N90_F109 Preis	FQA6N90_F109 Hersteller	FQA6N90_F109 Bild	FQA6N90_F109 Aktie	FQA6N90_F109 Inventar
FQA6N90_F109 Neu	FQA6N90_F109 Original	FQA6N90_F109 garantiert	FQA6N90_F109 RFQ	FQA6N90_F109 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited